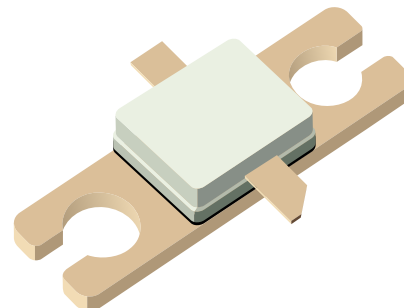


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В
 Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-81С
 Предназначен для работы в усилителях мощности до 6000 МГц

- Выходная мощность $P_{\text{вых}} = 5$ Вт
- Напряжение питания $U_{\text{си}} = 28$ В
- Коэффициент усиления по мощности $K_{\text{ур}} \geq 16,0$ дБ
- КПД стока $\eta_c \geq 50$ %



Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Максимально допустимый постоянный ток стока	I_c макс	1,0	А
Максимально допустимый прямой ток затвора	I_z (пр) макс	2,0	мА
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си макс}}$	130	В
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п макс}}$	225	°С
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	$R_{\text{т п-к}}$	7,0	°С/Вт

Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	I_c ост	$U_{\text{си}}=80$ В; $U_{\text{зи}}=-8$ В	-	-	1,0	мА	25±10
Крутизна характеристики	S	$U_{\text{си}}=10$ В; $I_c=0,4$ А	0,4	0,6	-	А/В	25±10
Ток стока насыщения	I_c нас	$U_{\text{си}}=6$ В; $U_{\text{зи}}=2$ В	1,6	2,0	-	А	25±10
Выходная мощность	$P_{\text{вых}}$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В $P_{\text{вых}}=0,13$ Вт $I_c=0,1$ А	5	7	-	Вт	(25±15)
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=5$ Вт $I_c=0,1$ А	16,0	17,5	-	дБ	(25±15)
КПД стока	η_c	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=5$ Вт; $I_c=0,1$ А	50	55	-	%	(25±15)

Габаритный чертеж

